

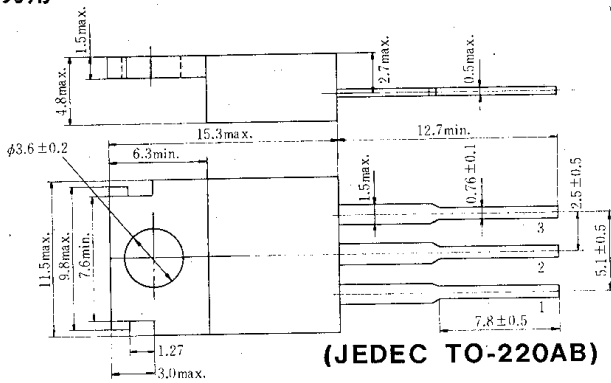
2SB689

シリコン PNP 三重拡散形

低周波電力増幅用
TV 垂直偏向出力用

SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
TV VERTICAL DEFLECTION OUTPUT



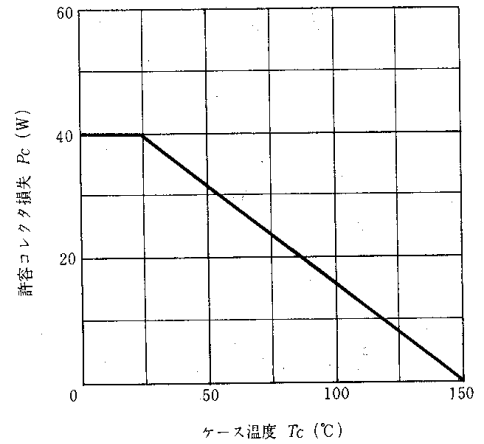
1. ベース: Base
 2. コレクタ: Collector
 3. エミッタ: Emitter
- (Dimensions in mm)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SB689	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-100	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-100	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-4	V
コレクタ電流	I_C	-4	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$	-5	A
許容コレクタ損失	P_C	1.8	W
	P_C^*	40	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-45~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値
* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit	
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-10\text{mA}, R_{BE}=\infty$	-100	—	—	V	
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-1\text{mA}, I_C=0$	-4	—	—	V	
コレクタ遮断電流	I_{CEO}	$V_{CE}=-80\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	-100	μA	
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-3.5\text{V}, I_C=0$	—	—	-50	μA	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=-1\text{A}, I_B=-0.1\text{A}$	—	—	-1.0	V	
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=-4\text{V}$	$I_C=-0.5\text{A}$	50	—	250	
			$I_C=-50\text{mA}$	25	—	350	